

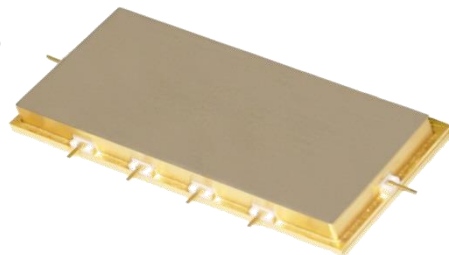
S帯 高効率高出力 GaN-HEMT 小型電力増幅器

FC7920G01

■ 特徴

各種レーダ等の送信システムへ適用可能な小型・高効率・高出力且つ信頼性に優れた S帯 GaN-HEMT 電力増幅器。

- 高電圧動作：ドレイン電圧 60 V 対応
- 高効率：電力負荷効率(PAE) 60 % Typ.
- 高出力電力：P1dB = 350 W Typ.



■ 推奨動作条件 (ケース取付面温度：25°C で規定)

- ドレイン - ソース間電圧：53 V
- ゲート - ソース間電圧：-0.9 V
- 送信入力電力：31 dBm
- 送信RFパルス幅：400 μs Max.
- 送信デューティ：4 % Max.

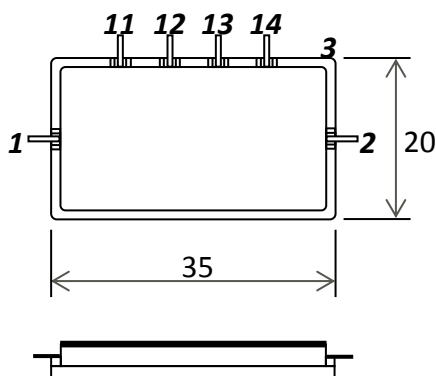
■ 最大定格

- ドレイン - ソース間電圧：100 V
- ゲート - ソース間電圧：-5 V
- ゲート電流：10 mA
- 全許容損失：130 W
- 入力最大電力：35 dBm
- チャンネル温度：250 °C
- 保存温度：-55 ~ +125 °C

■ 電気的特性 (ケース取付面温度：25°C で規定)

- 動作周波数帯域：2.9 ~ 3.4 GHz
- 出力電力：P1dB = 350 W Typ.
- 電力負荷効率(PAE)：60 % Typ.

■ 外形寸法 および 信号インターフェース



- 1 : RF_IN
- 2 : RF_OUT
- 3 : GND (Flange)
- 11 : Vg1 (Gate Voltage Input)
- 12 : Vd1 (Drain Voltage Input)
- 13 : Vg2 (Gate Voltage Input)
- 14 : Vd2 (Drain Voltage Input)

Unit : mm

※ 当カタログに記載している内容と製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

お問い合わせ先
 富士通株式会社
 特機システム事業本部 防衛営業統括部 R&D営業部

〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 野村不動産市ヶ谷ビル
 TEL : 03-3221-8305